

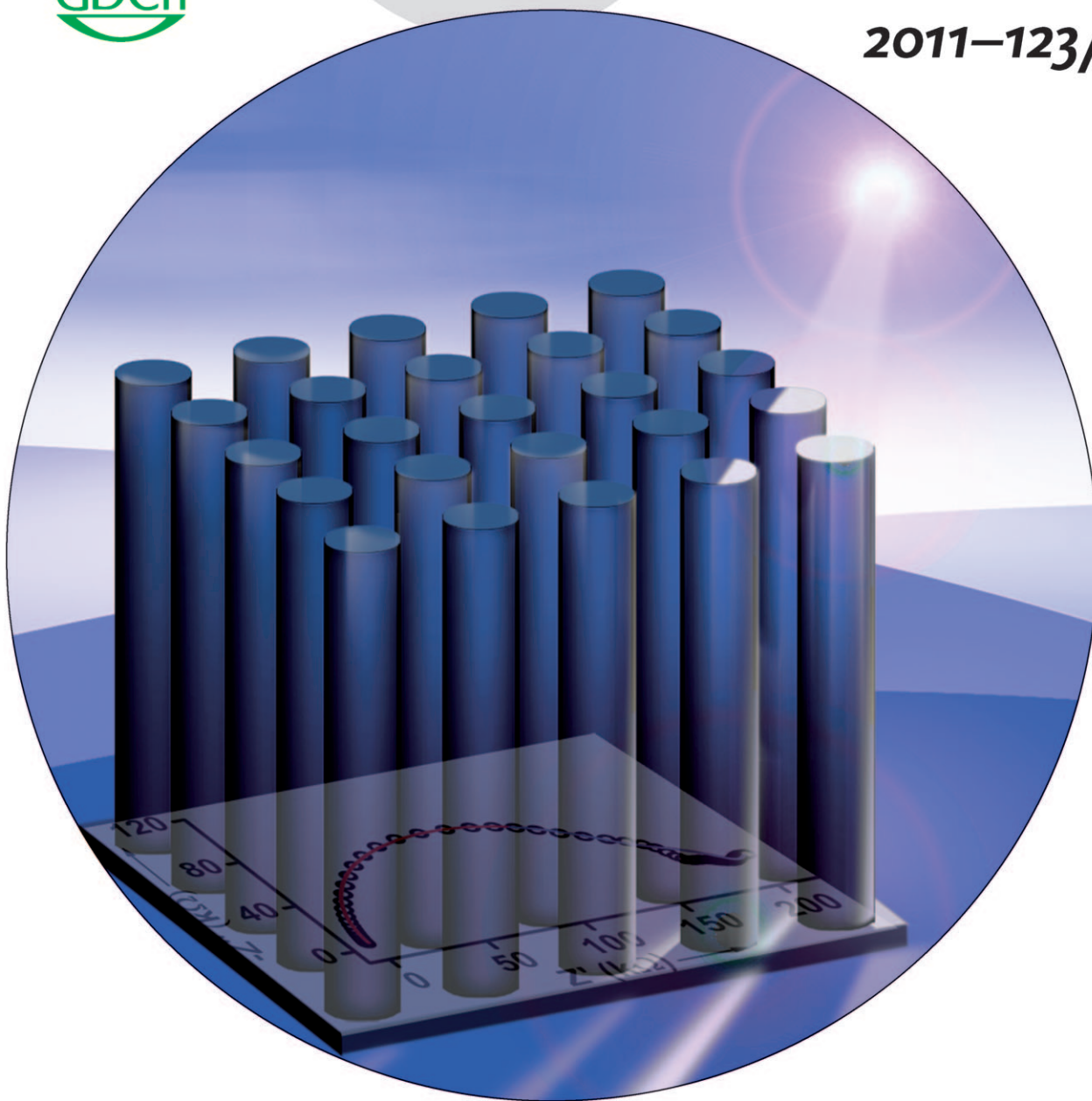
Angewandte Chemie

Eine Zeitschrift der Gesellschaft Deutscher Chemiker



www.angewandte.de

2011–123/10



Aus dem chemischen Wachstum ...

... resultierende Midgap-Zustände von Silicium-Nanodrähten sind der Hauptgrund für niedrige Solarenergieumwandlungseffizienzen. In ihrer Zuschrift auf S. 2382 ff. vergleichen D. Wang et al. sowohl durch stromloses Ätzen als auch durch chemisches Wachstum erhaltene Silicium-Nanodrähte von gleicher Größe, gleichem Dotierungsniveau und gleicher Kristallinität anhand elektrochemischer Methoden.

 WILEY-VCH

Rücktitelbild

Guangbi Yuan, Kenneth Aruda, Sa Zhou, Andrew Levine, Jin Xie und Dunwei Wang*

Aus dem chemischen Wachstum resultierende Midgap-Zustände von Silicium-Nanodrähten sind der Hauptgrund für niedrige Solarenergieumwandlungseffizienzen. In ihrer Zuschrift auf S. 2382 ff. vergleichen D. Wang et al. sowohl durch stromloses Ätzen als auch durch chemisches Wachstum erhaltene Silicium-Nanodrähte von gleicher Größe, gleichem Dotierungsniveau und gleicher Kristallinität anhand elektrochemischer Methoden.

